

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年3月4日(04.03.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/019398 A1

H01L 21/3065 (51) 国際特許分類7:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/010583

(22) 国際出願日:

2003年8月21日(21.08.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

2002年8月21日(21.08.2002) Ъ 2002年8月21日(21.08.2002) JP 2002年8月22日(22.08.2002) IP

特願2002-241250 特願2002-241802 特願2003-46097

特願2002-241124

2003年2月24日 (24.02.2003) TP

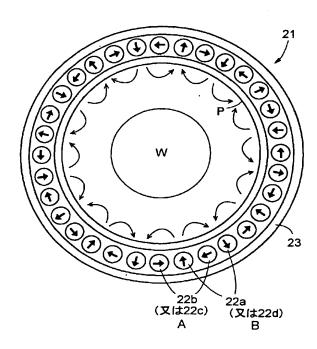
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 信越化学 工業株式会社 (SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒100-0004 東京都 千代田区大手町 二丁目 6番 1号 Tokyo (JP). 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都港 区赤坂 五丁目 3 番 6 号 Tokyo (JP):

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 宮田 浩二 (MIY-ATA, Koji) [JP/JP]; 〒915-0802 福井県 武生市北府 二丁 目 1 番 5 号 信越化学工業株式会社 磁性材料研究所 内 Fukui (JP). 手塚 一幸 (TEZUKA,Kazuyuki) [JP/JP]; 〒 407-8511 山梨県 韮崎市藤井町北下条 2381番地の 1 東京エレクトロンA T株式会社内 Yamanashi (JP). 達下 弘一 (TATESHITA, Koichi) [JP/JP]; 〒407-8511 山 梨県 韮崎市藤井町北下条 2381番地の1 東京 エレクトロンAT株式会社内 Yamanashi (JP). 小野 博夫 (ONO,Hiroo) [JP/JP]; 〒407-8511 山梨県 韮崎市 藤井町北下条 2381番地の1 東京エレクトロ

/続葉有/

- (54) Title: MAGNETRON PLASMA-USE MAGNETIC FIELD GENERATION DEVICE
- (54) 発明の名称:マグネトロンプラズマ用磁場発生装置



A... (OR 22c) B... (OR 22d)

(57) Abstract: A magnetron plasma-use magnetic field generation device provided on the outer side of a processing chamber for housing a substrate to be processed to perform a specified processing, having a plurality of magnet segments, and forming a specified multi-pole magnetic field around the substrate to be processed in the processing chamber, wherein the ability of controlling a multi-pole magnetic field intensity in the processing chamber can set a proper multi-pole magnetic field condition according to difference in plasma processing process, and further form a multi-pole magnetic field in conformity with the size of the substrate to be processed.

被処理基板を収容して所定の処 理を施すための処理室の外側に設けられ、複数 の磁石セグメントを有し、処理室内の被処理基 板の周囲に所定のマルチポール磁場を形成する マグネトロンプラズマ用磁場発生装置に関し、 処理室内のマルチポール磁場強度を制御できる ようにすることによって、プラズマ処理プロセ スの違いに応じて適切なマルチポール磁場の状 態を設定することができ、更に、被処理基板の サイズに合わせてマルチポール磁場を形成する ことができる。

WO 2004/019398 A1

ンAT株式会社内 Yamanashi (JP). 永関 一也 (NA-GASEKI,Kazuya) [JP/JP]; 〒407-8511 山梨県 韮崎市藤井町北下条 2381番地の1 東京エレクトロンAT株式会社内 Yamanashi (JP). 檜森 慎司 (HI-MORI,Shinji) [JP/JP]; 〒407-8511 山梨県 韮崎市藤井町北下条 2381番地の1 東京エレクトロンAT株式会社内 Yamanashi (JP).

- (74) 代理人: 森崎 俊明 (MORISAKI, Toshiaki); 〒104-8604 東京都中央区明石町1番3号 ツインクロス1001 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK,

SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。